

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za elektrotehniko

Vid Oblak

Simulator elektrostatične raztelevtritve

Poročilo o delu

Visokošolski strokovni študijski program
prve stopnje Aplikativna elektrotehnika

Mentor: Izr. Prof. Dr. Peter Zajec

Ljubljana, 2021

Zahvala

Zahvaljujem se mentorju dr. Petru Zajcu in mentorju v podjetju Blažu Prahu, katera sta mi pomagala z nasveti, izračuni in realizacijo projekta. Zahvaljujem se tudi sodelavcu Janu Pogačarju, kateri mi je vskočil na pomoč pri uporabi Python in LaTeX. Prav tako se zahvaljujem vsem ostalim sodelavcem in prijateljem, kateri so tudi v najmanjši meri pomagali pri razvoju ali realizaciji projekta.

Povzetek

V tem zaključnem poročilu je opisan razvoj simulatorja elektrostatične razelektritve za integrirana vezja in problemi, ki sem jih imel pri razvoju. Simulator je sestavljen iz treh glavnih modulov in sicer kontrolne ploščice, nastavljivega visokonapetostnega napajalnika in visokonapetostnega stikala. Zaradi trenutne gospodarske situacije smo se tekom razvoja projekta odločili da bomo dali povdarek na ugodni ceni. Ta zahteva je pomenila razvoj in izdealvo nastavljivega visokonapetostnega napajalnika in visokonapetostnega stikala, namesto nakupa le teh. Vsi moduli projekta so bili načrtovani z modularnostjo v mislih, da v primeru kasnejše nadgradnje ali zamenjave ta poteka čim bolj ne moteno. Vendar tekom projekta sem ugotovil, da izdelava simulatorja, kateri bi ustrezal vsem standardom bi zahtevala precej več časa in večji proračun.

Ključne besede: ESD, Elektrostatika, Simulator elektrostatične razelektritve, mikroelektronika

Abstract

In this final report is description of development of ESD simulator for microelectronics and problems which I experienced within development. Simulator is made of three main modules: main control board, adjustable high-voltage power supply and high-voltage switch. Due to current economy situation we have decided to put emphasis on low-cost of the simulator. This meant development and manufacturing of our own adjustable high-voltage power supply and high-voltage switch, instead of purchasing. All modules of the simulator were designed to be modular and swappable, that way upgrades or replacements can be made without major disruption. But during development I have come to conclusion that ESD simulator which would fit the requirements can't be made in specified time frame and with current budget.

Key words: ESD, Electrostatic, ESD Simulator, microelectronics

Vsebina

1	Uvod	1
2	Simulator elektrostatične razelektritve	5
2.1	Praktično uposabljanje	5
2.2	Zasnova simulatorja elektrostatične razelektritve	6
2.2.1	Moduli simulatorja	7
2.2.2	Nastavljivi visokonapetostni napajalnik	8
2.2.3	Regulacija napetosti	10
2.2.3.1	LM5155	10
2.2.3.2	UCC28740-Q1	10
2.2.3.3	LT3748	11
2.2.3.4	LT3757	11
2.2.3.5	LT8304	12
2.2.3.6	Ugotovitve	13
2.2.3.7	Krmilnik z mikrokrmilnikom	13
2.2.4	Visokonapetostno stikalo	16

2.2.4.1	Komercialno dobavljivi releji	16
2.2.4.2	Komercialna tranzistorska rešitev	20
2.2.4.3	Samogradnja tranzistorskega visokonapetostnega stikala	20
2.2.4.4	Mehanska rešitev	21
3	Sklep	27

Seznam slik

1.1	Osnovna shema ESD simulatorja.	3
2.1	Osnovna shema ESD simulatorja.	6
2.2	Shema blok diagrama.	7
2.3	Shema vezja v LTSpice.	12
2.4	Shema visokonapetostnega krmilnika z mikrokrmilnikom.	14
2.5	Shema programske kode visokonapetostnega krmilnika z mikrokrmilnikom.	15
2.6	Slika releja G61A proizvajalca Gigavac.	17
2.7	Slika releja serije H proizvajalca Meder.	18
2.8	Shema vezja za merjenje relejev.	18
2.9	Skakanje kontaktov pri releju proizvajalca Medler electronics.	19
2.10	Shema idejne zasnove krmiljenja tranzistorja preko "Switched Cap".	21
2.11	Shema stikala s solenoidom verzija 1.	22
2.12	Shema stikala s solenoidom verzija 2.	22
2.13	Shema stikala s servo motorjem verzija 1.	23

2.14 Shema stikala s servo motorjem verzija 2.	24
2.15 Potek napetosti po sklenitvi kontaktov pri servo stikalu verzija 1.	25
2.16 Potek napetosti po sklenitvi kontaktov pri servo stikalu verzija 1 povecano.	26

Seznam tabel

2.1	Ožji izbor regulatorjev	10
-----	-----------------------------------	----

Seznam uporabljenih simbolov

V pričujočem zaključnem delu so uporabljene naslednje veličine in simboli:

Veličina / oznaka		Enota	
Ime	Simbol	Ime	Simbol
čas	t	sekunda	s
frekvenca	f	Hertz	Hz
napetost	U	Volt	V
tok	I	Amper	A
upornost	R	Ohm	Ω

Natančnejši pomen simbolov ter njihovih indeksov je razviden iz ustreznih slik ali pa je pojasnjen v spremljajočem besedilu, kjer je simbol uporabljen.

1 Uvod

Praktično uposabljanje sem opravljal v podjetju Renishaw d.o.o., podjetje se ukvarja z integriranimi vezji za specifično uporabo (ASIC). Podjetje je bilo ustanovljeno leta kot hčerinsko podjetje Britanskega podjetja Renishaw p.l.c. Zaposleni so razdeljeni na tri skupine:

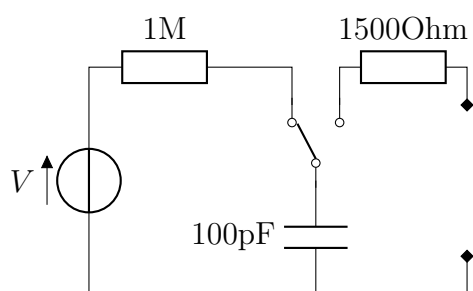
- načrtovalci: načrtujejo posamezne sklope integriranega vezja in karakterizirajo vezje s pomočjo simulacij.
- postavljalci: postavijo posamezne komponente na površino integriranega vezja (podobno kot risanje tiskanih vezij).
- testni inženjerji: karakterizirajo narejena integrirana vezja, načrtujejo testna vezja in skrbijo za testiranje vezij za proizvodnjo.

Sam sem izvajal praktično usposabljanje v skupini testnih inženjerjev. Pod to skupino delam v tem podjetju že 3 leta, zaradi tega so mi bile poznane že vse procedure in sem se lahko takoj lotil naloge. Zadana mi je bila naloga izdelave simulatorja elektrostatične razelektritve, kateri se uporablja pri vertifikaciji integriranih vezij. Zahteve so bile po maksimalni napetosti vsaj 15 kV, nastavlljivost izhodne napetosti med 250 V in 15 kV, natančnost izhodne napetosti vsaj 3% ter ustrežanje CE zakonodaji.

Za potrebe testiranja integriranih vezij smo v podjetju potrebovali simulator elektrostatične razelektritve. Na začetku snovanja so bile zastavljene specifikacije maksimalne napetosti 15kV in uporaba že narejenih modulov za nastavljivi visokonapetostni napajalnik ter visokonapetostno stikalo. Tekom projekta se je

to spremenilo in prišlo do odločitve o lastnem načrtovanju nastavljivega visokonapetostnega napajalnika. Pri tem modulu smo imeli kar nekaj tehničnih ovir za prebrosti. Največji sta bili ustrezanje regulacijam CE ter zagotavljanje 15kV izolacije med primarno in sekundarno stranjo. Prvotni načrti so bili lastno navijanje primernege step-up transformatorja. Po kar nekaj mertivah in izračunih se je to pokazalo za neprimerno, saj nismo uspeli zagotoviti željene napetosti in izolacije. Rezervni načrt je bil razdredi televizor s katodno cevjo in iz tam vzeti ven transformator. Tega smo se želeli kar se da izogniti saj se že trenutno težko najde televizorje s katodno cevjo, čez leta se bo pa še težje. Motilo me je pa tudi razlikovanje transformatorjev tako v podnožju kot v karakterisitkah in vgrajene diode v sekundarnem navitju zagotovo ne pomagajo pri karakterizaciji transformatorja. Regulacija napetosti nam je povzročala probleme zaradi zagotavljanja željene izolacije. S pomočjo simulacij smo preizkusili kateri tipi krmilnikov bi nam ustrezali. Izločili smo vse neizolirane krmilnike, krmilnik s povratno vezavo preko optičnega spojnika, zaradi nelinearnosti le tega ni bil zmožen pokrivati celotne izhodne napetosti od 250 V do 15 kV, krmilnik s povratno vezavo preko pomožnega navitja je v simulacijah izgledal obetavno vendar se je na koncu izkazal za neprimernege. Kot primeren se je izkazal samo regulator ima povratno vezavo preko primarnega navitja in sicer z merjenjem zrcaljene napetosti z sekundarnega navitja na primarno. Vendar nas je tudi ta razočaral po obsežnejših meritvah. Na koncu smo naredili regulator z mikrokrmilnikom, kateri prejema povratno vezavo preko galvansko ločenega analogno-digitalnega pretvornika. Po standardih MIL-STD-883K [1] in JS-001-2007 [2] mora biti visokonapetostno stikalo, katero prazni kondenzator skozi napravo pod testom t.i. "bounce-less", sepravi ko sklene kontakt ga mora zadržati namesto, da ga na krato večkrat razklene in sklene. Standarda pa tudi predpisujeta obliko signala toka skozi napravo pod testom zato šnubber" vezje čez kontakte stikala ni primerna rešitev. Za nižje napetosti obstajajo releji kateri vsebujejo živo srebro, katerega naloga je zadržati kontakt, ko se kontakta odbijeta. Vendar takšnega releja za 15 kV je okoli €2000. Kompromis je bil izdelava svojega stikala, katero bo ustrezalo zahtevam.

Princip delovanja simulatorja elektrostatične razelektritve je dokaj enostaven. Nastavljivi visokonapetostni vir polni kondenzator, katerega se nato preko upora prazni skozi napravo pod testom.



Slika 1.1: Osnovna shema ESD simulatorja.

2 Simulator elektrostatične razelektritve

2.1 Praktično uposabljanje

Načrtovalski del projekta, sem delal na svojem računalniškem delovnem mestu, kjer sem uporabljal:

- Altium Designer: risanje električnih shem in načrtovanje tiskanih vezij
- Visio: risanje blok diagramov in konceptnih shem
- LTSpice: simulacija analognih vezij
- STM32Cube: programiranje mikrokontrolerov ARM STM32
- Python: komunikacija med mikrokontrolerom in računalnikom

Na mizi sem imel antistatično podlogo, vendar to delovno mesto ni bilo namenjeno meritvam, kvečjem hitrim meritvam, s katerimi sem potrdil koncept. Za obsežnejše meritve sem imel na voljo merilno mesto, kjer je bilo tudi na voljo več merilnih instrumentov. Pri svojem delu sem največ uporabljal:

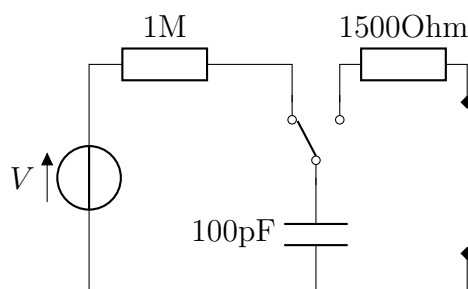
- Rigol DS1054Z: digitalni osciloskop
- Acute ADP2100 : visokonapetostna diferencialna sonda
- Rigol DP832: 3 kanalni laboratorijski napajalnik

- PeackTech 3450: multimeter z vgrajeno termalno kamero

Pred delom z visoko napetostjo je bilo potrebno opraviti interni tečaj varstva pri delu z visoko napetostjo. Po posvetu z mentorjem sva sklenila razdeliti nalogo po posameznih modulih. Za vsak modul sem naprej pripravil blokovno shemo, ter opis možnih rešitev, po pregledu le teh je sledilo nadaljno simuliranje v LTSpice in ko smo bili zadovoljni z rezultati še načrtovanje v Altium Designer.

2.2 Zasnova simulatorja elektrostatične razelektritve

Poleg že omenjenih specifikacij je veljalo tudi, da mora simulator ustrezati standardoma MIL-STD-883K in JS-001-2007. Osnovna shema simulatorja je sledeča:

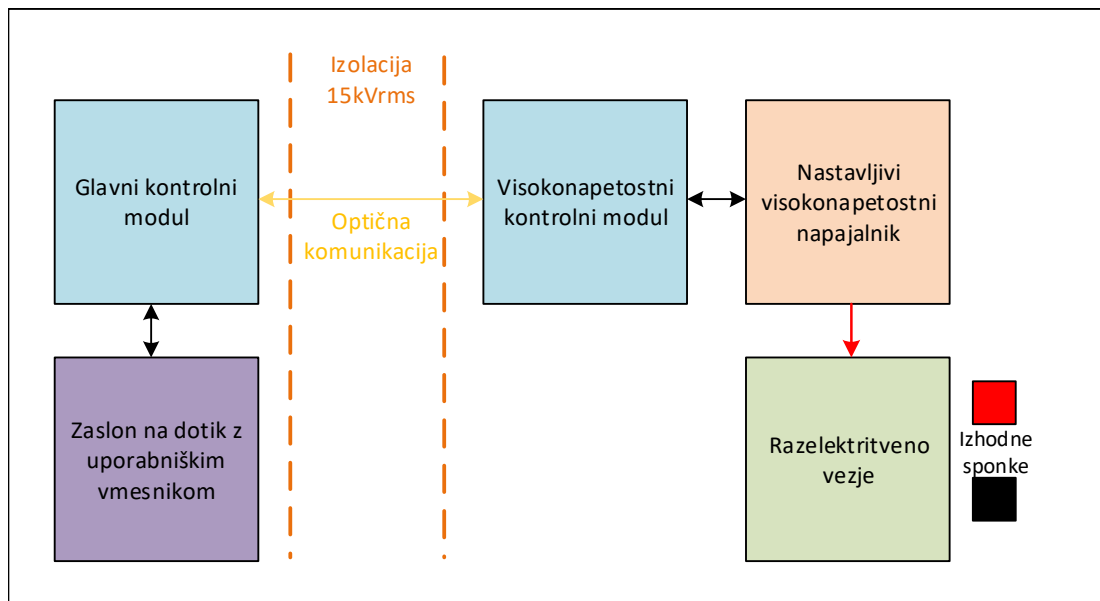


Slika 2.1: Osnovna shema ESD simulatorja.

Sestavljajo ga nastavljeni visokonapetostni izvir, polnilni upor, praznilni kondenzator, praznilni upor ter ne-preskakovalno (t.i. bounce-less) stikalo. Preko polnilnega upora se napolni praznilni kondenzator na željeno napetost, katerega se preko praznilnega upora sprazni skozi napravo pod testom. Izhodni tok mora vstrezati limitam katere so podane v standardih: dvizni čas mora biti manjši kot 10 ns ter nominalni čas praznenja kondenzatorja skozi kratki stik mora biti 150 ns z maksimalno deviacijo ± 20 ns. Slednja zahteva pomeni, da z stikalom, povezovalnimi žicami in konektorji smemo dodati maksimalno 20 pF, saj drugače bo čas spraznitve skozi kratki stik odstopal zahtevanemu. Pri načrtovanju visokonapetostnega izvira je prav tako potrebno biti previden, saj mora zagotavljati 15 kV izolacije med primarno in sekundarno stranjo.

2.2.1 Moduli simulatorja

Simulator je sestavljen in 4 modulov, od katerih vsak opravlja posebno nalogo.



Slika 2.2: Shema blok diagrama.

- Glavni kontrolni modul: krmili visokonapetostni modul, prejema uporabnikove ukaze preko zaslona na dotik, pošilja podatke po LAN ali USB
- Visokonapetostni kontrolni modul: krmili nastavljivi visokonapetostni napajalnik in razelektritveno vezje po ukazih glavnega kontrolega modula, varnostno odklaplja napajanje nastavljivega napajalnika, ko le ta ni v uporabi
- Nastavljivi visokonapetostni napajalnik: po zahtevah regulira napetost od 250 V do 15 kV
- Razelektritveno vezje: izprazni naboj iz praznilnega kondenzatorja prek naprave pod testom

2.2.2 Nastavljivi visokonapetostni napajalnik

Začel sem z nastavljivim visokonapetostnim napajalnikom, saj sem pričakoval, da bo z njim največ dela in na koncu je tudi bilo tako. Z visokimi napetostmi nisem imel nobenih izkušenj, imel sem pa nekaj izkušenj z Cockcroft-Walton-ovim množilnikom napetosti. Hotel sem narediti stikalni napajalnik, kateri bi pretvarjal 24 V v 250 V za njim pa 60 stopenj množilnika. Regulaciji napetosti na transformatorju bi sledila tudi izhodna napetost množilnika. Po simulacijah, sem hitro ugotovil, da to ne bo delovalo po pričakovanjih, saj so kapacitivne izgube previsoke. Prvotno sem mislil samo dodati nekaj stopenj vendar sem hitro ugotovil, da tudi če dodam še 60 stopenj ne bom dosegel 15 kV iz 250 V. Našel sem pa članek, kjer so se soočali s podobnim problemom [3], po računih in simulacijah je rešitev izgledala obetavno. Zaradi navdušenja nad rezultati sem se lotil risanja sheme in tiskanega vezja v Altium Designerju. Na srečo smo mojo napako ugotovili, preden smo dali tiskano vezje v izdelavo. Za povratno zanko regulacije sem uporabil analogno-digitalni pretvornik s primerno dimenzinernem preduporom in s tem sem prekinil izolacijo med primarjem in sekundarjem. Sklenili smo, da bo verjetno najboljša možnost za dvigovanje napetosti samo z transformatorjem. Po povpraševanjih pri večjih ponudnikih elektronskih komponent sem prišel do zaključka, da primerne transformatorja ne bo možno kupiti vendar ga bo potrebno narediti. V preteklosti sem že navijal omrežne transformatorje, z načrtovanjem flyback transformatorjev, se pa še nisem srečal. Za začetek sem uporabil jedra RM10 iz materiala N87, katera sem našel v laboratoriju, izračunal sem le koliko obratov rabim na primarni strani, preden preide v nasiženje pri 3 A. Navil sem enega z razmerjem 1:10 in enega z 1:20.

Preden sem opravil meritve sem moral narediti še napetostni delilnik za visokonapetostno sondo, saj je le ta narjena samo za 1.8 kV. Po specifikacijah ima vhodno vpornost $2\text{ M}\Omega$, kar pomeni z $18\text{ M}\Omega$ preduporom, dosežemo razmerje 1:10 in posledično maksimalno napetost 18 kV. Pri tem je potrebno poudariti, da nisem dodal kapacitivne kompenzacije in sonda je bolj uporabna za indikacijo kot pa meritve. Tuljavo sem krmilnik s pomočjo MOSFETA in namenskega krmilnika UCC27517 [4] proizvajalca Texas Instruments.

Zaradi izredno kratkega časa vzpona in padca nam omogoča opravljanje me-

ritve tudi pri višjih frekvencah. Maksimalni izhodni tok 4 A nam omogoča hitro odpiranje/zapiranje MOSFETov z višjim U_{DS} . Z signalnim generatorjem sem lahko natančno kontroliral krmilnik. Meritve sem opravljal od 1 % do 10 % delovnega cikla, pri napetostih 5 V, 10 V in 15 V. Omejitev toka sem nastavil na 3 A, vendar ta ni bila tako pomembna, saj sem imel paralelno iznodnim sponkam vezan še 4700 μ F elektrolitski kondenzator. Pri meritvah sem ugotovil, da napetost U_{pp} lahko brez problema doseže zahtevanih 15 kV, vendar se sliši prebijanje napetosti med navitji transformatorja. Odločil sem se narediti meritve še z tremi različnimi jedri. Pri iskanju jedra, sem si pomagal z skripto katero sem napisal v Matlabu, katera mi glede na A_L in l_e parametre izračuna potrebno razmerje navojev in maksimalni magnetilni tok. Odločili smo se za sledeča jedra: EFD 30/15/9, PM 50/39 in E 70/33/32 z 1.5 mm režo. Večja transformatorja sta izgledala zelo obetavno, saj bi na tuljavniku lažje zagotavljal primerno izolacijo ter visoka A_L vrednost pomeni manjše število ovojjev. Iz radovednosti sem pomeril tudi dva flyback transformatorja, katera sem naročil kot vzorca od proizvajalca CoilCraft in sicer GA3459 [5] in GA3460, sta pa namenjena za 500 V. Po mertivah sem prišel do ugotovitev, da transformatorja z velikim jedrom delujeta pod pričakovanji, transformatorja od proizvajalca CoilCraft delujeta izredno dobro in skoraj dosejata željene napetosti najboljše se je izkazal mali transformator z EFD jedrom.

Ime	L_{pri}	L_{sec}	Razmerje	U_{ppMAX}	Jedro	Reža
GA3460	2.6 μ H	253 μ H	1:10	3.9 kV	EFD 25/13/9	0.5 mm
GA3459	5 μ H	505 μ H	1:10	13.8 kV	EFD 25/13/9	0.5 mm
Mali z EFD	76 μ H	13.21 mH	1:13	7.84 kV	EFD 30/15/9	0 mm

Z rezultati meritev nisem bil najbolj zadovoljen, vendar sem se odločil najprej ugotoviti način regulacije izhodne napetosti in se kasneje po potrebni prilagoditi parametre transformatorja.

2.2.3 Regulacija napetosti

Prvotno sem si želel skrajšati čas načrtovanja in vzeti že narejeni regulator in po potrebi prilagoditi vezje okoli njega - vezje povratne zanke. Glede na obstoj številnik krmilnikov namenjenih za Flyback topologijo, sem tam začel iskanje primernih, sledeče sem izbral v ožji izbor:

Ime	Proizvajalec	Način povratne zanke
LM5155	Texas Instruments	Optoizolator
UCC28740-Q1	Texas Instruments	Optoizolator
LT3748	Linear Technology	Zaznavnje na primarnem navitju
LT3757	Linear Technology	Napetostni delilnik na izhodu
LT8304	Linear Technology	Zaznavanje na primarnem navitju

Tabela 2.1: Ožji izbor regulatorjev

2.2.3.1 LM5155

Krmilnik [6] ima avtomatsko regulacijo frekvence v območju od 170 Hz do 100 kHz. Povratna vezava je izolirana preko optičnega spojnika, kateri je prožen na izhodni strani preko napetostnega delilnika in Zennerjeve diode. Z spreminjanjem vrednosti upora povratne vezave se spreminja točka, pri kateri se proži optični spojnik. Kljub ponovnim izračunom in dvojnemu preverjanju sheme mi tega krmilnika ni uspelo spraviti v delovanje, dolgi časi dobave so mi pa preprečili prototipni test.

2.2.3.2 UCC28740-Q1

UCC28740-Q1 deluje po enakem principu kot že omenjeni LM5155. Vendar je ta krmilnik namenjen delovanju usmerjeni omrežni napetosti, saj od tam dobi podatek o referenčni frekvenci. Tak krmilnik mi ne služi kaj dosti, ker smo določili napajalno napetost na 24V enosmerne.

2.2.3.3 LT3748

Krmilnik je zelo zanimiv, saj ne potrebuje dodatne povratne vezave, informacijo o izhodni napetosti namreč dobi preko zrcaljene napetosti na primarnem navitju. Ko se izključi N Kanalni MOSFET, napetost na ponoru zraste nad vhodno napetost, katera je enaka $V_{FLBK} = (V_{OUT} + V_F + I_{SEC} * ESR) * N_{PS}$, ta napetost steče proti masi preko R_{FB} in interno zaporedno vezanim R_{REF} , točka med uporoma je vezana na invertirajoči vhod ojačevalnika napake z referenco 1.223 V [7]. Izhodna napetost je enaka $V_{OUT} = V_{BG}(R_{FB}/R_{REF})(1/N_{PS}) - V_F - I_{SEC}(ESR)$, kjer lahko pri naših napetostih zanemarimo V_F in $I_{SEC}(ESR)$, upoštevati pa moramo tudi zahteve za minimalno induktivnost primarnega navitja:

$$L_{PRI} \geq \frac{(V_{OUT} + V_{F(DIODE)}) * R_{SENSE} * t_{Settle(MIN)} * N_{PS}}{V_{Sense(MIN)}}$$

$$V_{SENSE(MIN)} = 15 \text{ mV}$$

$$t_{SETTLE(MIN)} = 400 \text{ ns}$$

$$N_{PS} = \text{razmerje ovojcev med primarnim in sekundarnim navitjem}$$

Oziroma (uporabi se tisto vrednost, katera je večja):

$$L_{PRI} \geq \frac{V_{IN(MAX)} * R_{SENSE} * t_{ON(MIN)}}{V_{SENSE(MIN)}}$$

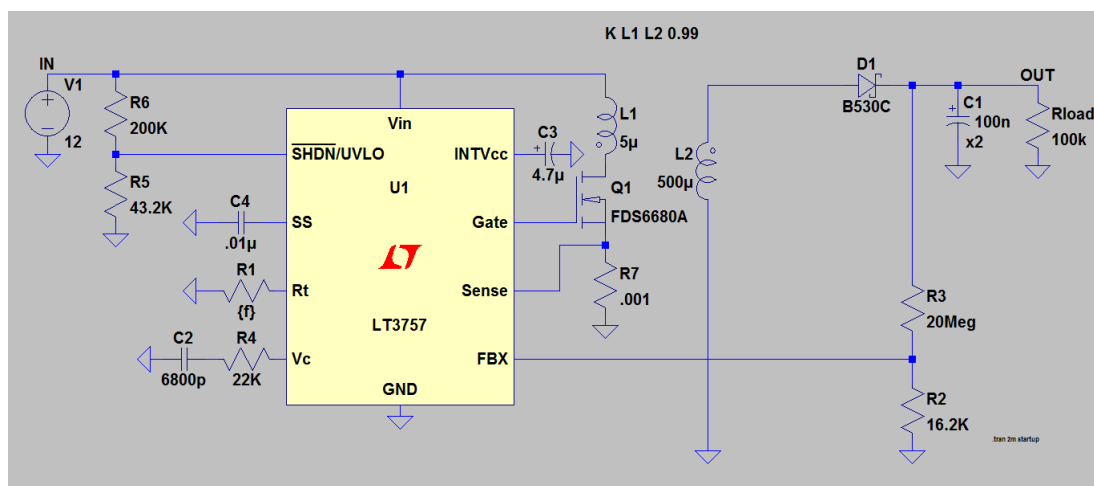
$$t_{ON(MIN)} = 250 \text{ ns}$$

Pri transformatorjih za katodne cevi pa vrednost primarnega navitja okoli desetkrat manjša, kar pojasni čudno obnašanje.

2.2.3.4 LT3757

Krmilnik LT3757 proizvajalca Linear Technology [8] je krmilnik pri kateremu se nastavlja obratovalno frekvenco z enim uporom v razponu med 100 kHz in 1 MHz. Napetost se nastavlja z napetostnim delilnikom na sekundarni strani, da pri željeni izhodni napetosti je izhod napetostnega delilnika enak 1.6 V. Na spletni strani od produkta je bilo možno dobiti vezje regulatorja, kateremu sem

spremenil vrednosti določenih elementov po mojih potrebah. Po nekaj simulacijah je hitro postalo jasno, da je omenjeni krmilnik primeren za projekt, saj sem uspel nastavljati izhodno napetost med 300 V in 5 kV.



Slika 2.3: Shema vezja v LTSpice.

Vendar je problem iz vidika varnosti, sekundarno navitje visokonapetostnega transformatorja je električno povezan z nizkonapetostno stranjo. Za zagotavljanje primerne izolacije bi moral napajalnik modula zdržati 15 kV, kar zopet pomeni načrtovanje takega napajalnika saj napajalniki z najvišjo prebojno trdnostjo so takšni pod certifikatom IEC 60601-1 po katerem je najvišja prebojna trdnost 4000 VAC.

2.2.3.5 LT8304

LT8304 proizvajalca Linear Technology [9] deluje po podobnem principu kot LM3748 z razliko, da ima vgrajen MOSFET in posledično manjšo izhodno moč. Simulacije so bile obetavne vendar sem jih vzel z rezervo zaradi netočnosti modela transformatorja. Vseeno sem se odločil naspajkati krmilnik in pripadajoče komponente na prototipno ploščico. Vezje je delovalo po pričakovanjih, vendar po približno 20 sekundah se je pokadilo iz krmilnika. Mislil sem, da je to bil samo problem z dotičnim krmilnikom in sem uporabil novega. Tudi pri temu se

je pokadilo. Dotični krmilnik ima maksimalno moč 24 W vendar pri meritvah moč ni presegla 10 W. Potrebno se je pa zavedati, da je bil na izhodu napajalnika kondenzator z 4700 μF , zaradi katerega napajalnik ni pokazal visokih tokovnih špic. Drugi del, ker bi lahko prihajalo do napake je na pinu SW, kateri je ponor internega MOSFETA in lahko, da inducirana napetost na primarnem navitju je višja od U_{DSMAX} in posledično poškoduje čip. Podatkovni list narekuje uporabo shotky in zener diodo s pragovno napetostjo $V_{Zener(MAX)} \leq 145\text{V} - V_{IN(MAX)}$ proti napajalni liniji za odvajanje prenapetostnih špic. V mojem primeru sem uporabil zener diodo z pragovno napetostjo 100 V vendar očitno ni bila dovolj. Imel sem še en krmilnik pri katerem sem namesto priporočene prenapetostne zaščite uporabil TVS diodo z nominalno napetostjo 70 V in maksimalnim tokom 26.5 A. Toda rezultat je bil še vedno isti.

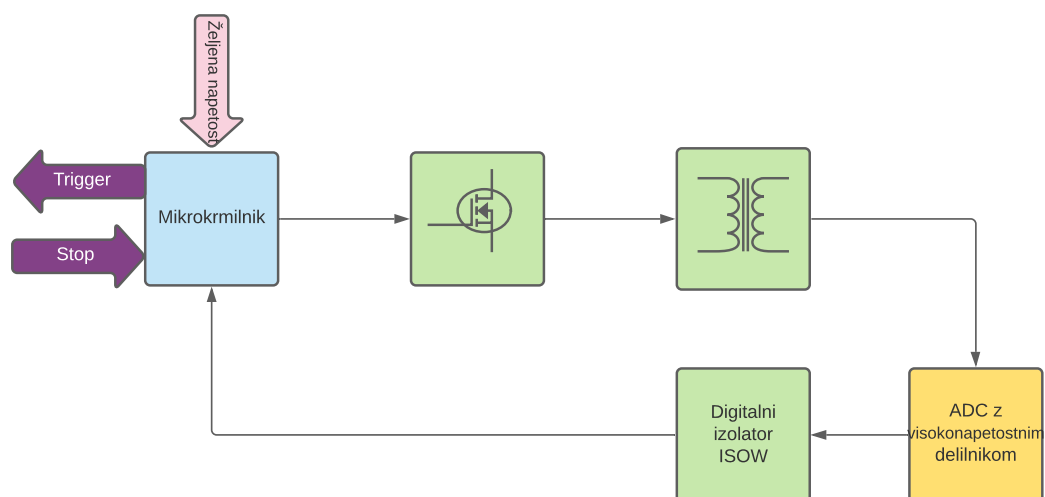
2.2.3.6 Ugotovitve

Po vseh simulacijah se je izkazalo, da ne bo mogoče uporabiti že narejenega krmilnika vendar bo potrebno tudi krmilnik načrtovati iz od začetka. Možna rešitev je tudi uporaba baterijskega napajanja za visokonapetostni napajalnik, vendar je potrebno med polnilnik in baterijo vstaviti odklopnik kateri ima prebojno napetost vsaj 15 kV. Takšen odklopnik zopet pomeni nekaj zelo specifičnega in dragega ali pa samo izdelava.

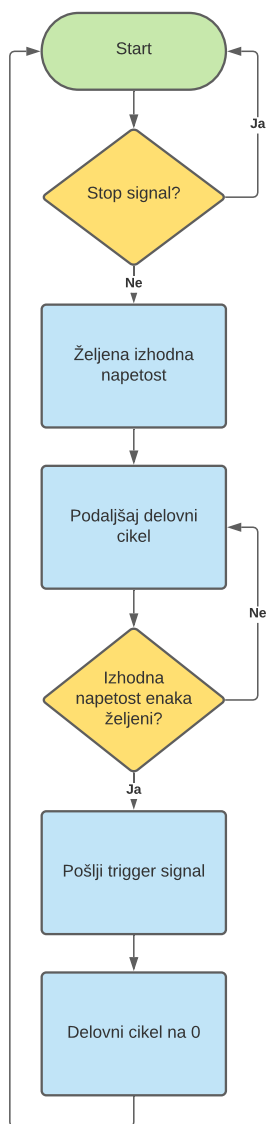
2.2.3.7 Krmilnik z mikrokrmilnikom

Edina možnost, ki nam je še ostala je bila izdelava visokonapetostnega krmilnika z mikrokrmilnikom. Krmilnik bo opravljal le vlogo krmiljenja visokonapetostnega napajalnika. Vhodni signal bo prejel preko serijske povezave, povratna vezava bo pa preko analogno-digitalnega pretvornika, kateri bo na mikrokrmilnik povezan preko optičnega izolatorja za digitalne povezave. Za mikrokrmilnik je bil uporabljen STM32 iz družine F4, saj njegove operacije niso tako kritične in je lahko uporabljen praktično kateri koli mikrokrmilnik. Z STM Cube razvojem okoljem sem imel izkušnje že od prej, razvojno ploščico STM NUCLEO F4 sem pa imel v predalu. Analogno-digitalni pretvornik tudi ni bil kritičen, saj za koncept nismo rabili neke visoke natančnosti, galvansko ločitev med visokonapetostnim in

niskonapetostnim delom je zagotavljal digitalni izolator z vgrajenim izolatorjem napajanja iz družine ISOW proizvajalca Texas Instruments.



Slika 2.4: Shema visokonapetostnega krmilnika z mikrokrmilnikom.



Slika 2.5: Shema programske kode visokonapetostnega krmilnika z mikrokrmilnikom.

Programska koda preveri, če glavni krmilnik še pošilja STOP signal, če ga ne prebere željeno napetost preko serijske povezave in nastavi delovni cikel na najkrajšega. Dokler izhodna napetost ne doseže nastavljene, počasi povečuje delovni cikel. Ko izhodna napetost doseže nastavljeno, pošlje glavnemu krmilniku TRIGGER signal, sepravi signal kateri sproži praznilni rele in postavi delovni cikel na 0. Počasno dviganje napetosti nam omogoča počasnejše polnenje kondenzatorja in posledično potrebujemo manjši transformator.

2.2.4 Visokonapetostno stikalo

Standard zahteva "bounce-less" stikalo sepravi stikalo, katero ko sklene kontakt ga ne razklene več. V preteklosti so se prodajali releji, kateri so imeli kontakte v kapsuli in notri malo živega srebra. Živo srebro je poskrbelo, da v času ko sta bila kontakta odbita je tok lahko še vedno tekkel preko živega srebra. Vendar zaradi direktive RoHS je izbira takšnih relejev zelo omejena.

2.2.4.1 Komercialno dobavljivi releji

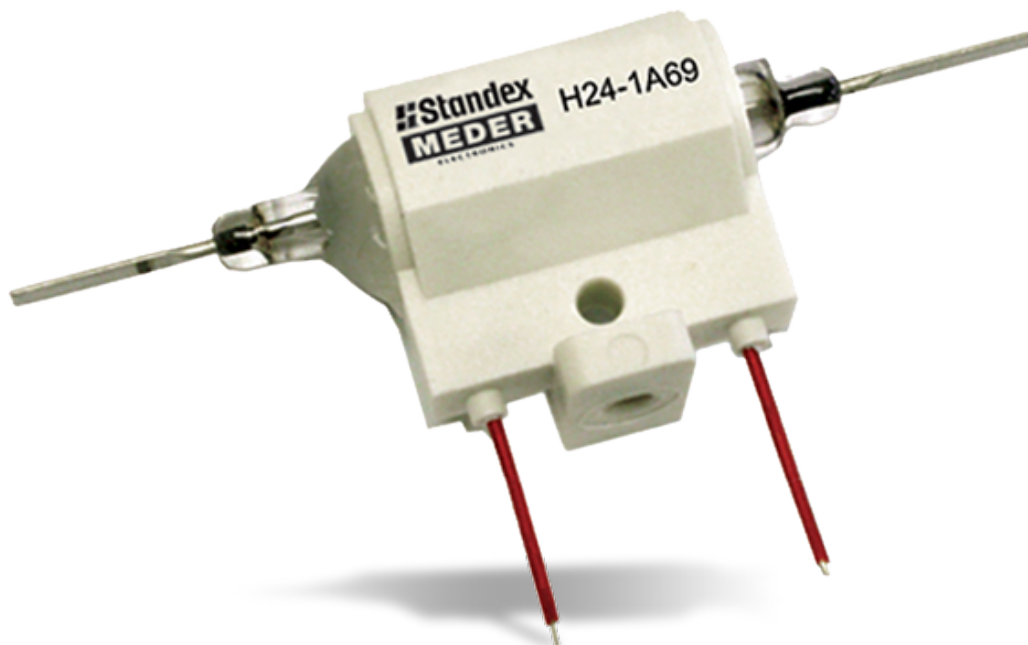
Prvotna izbira je bil model G61A proizvajalca Gigavac [10], kateri se tudi nahaja v simulatorjih elektrostatične razelektritve, saj je v specifikacijah poudarjeno: Odličen za praznjenje kondenzatorjev ter učinkovito operira brez "bouncinga".



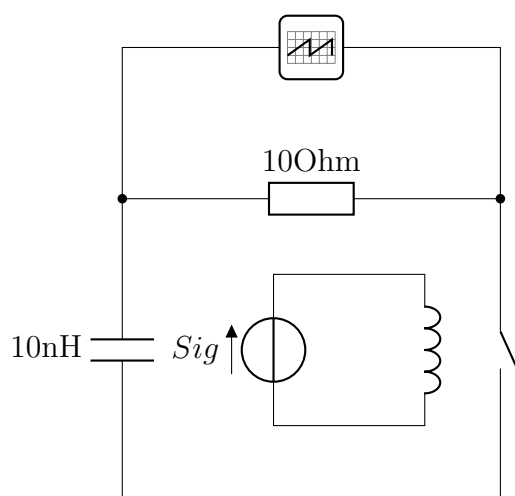
Slika 2.6: Slika releja G61A proizvajalca Gigavac.

Vendar se cena takšenga releja giba okoli 2000€. Zaradi omejenega proračuna ni bilo mogoče odobriti nakup dotičnega releja. Dobra alternativa se je zdel rele serije H proizvajalca Medler electronics [11] (sedaj Standex electronics) kateri ima v specifikacijah navedeno "Zamenjava za mokre releje z živim srebrom". Pri ceni okoli 50€ se je to zdelo predobro, da bi bilo res.

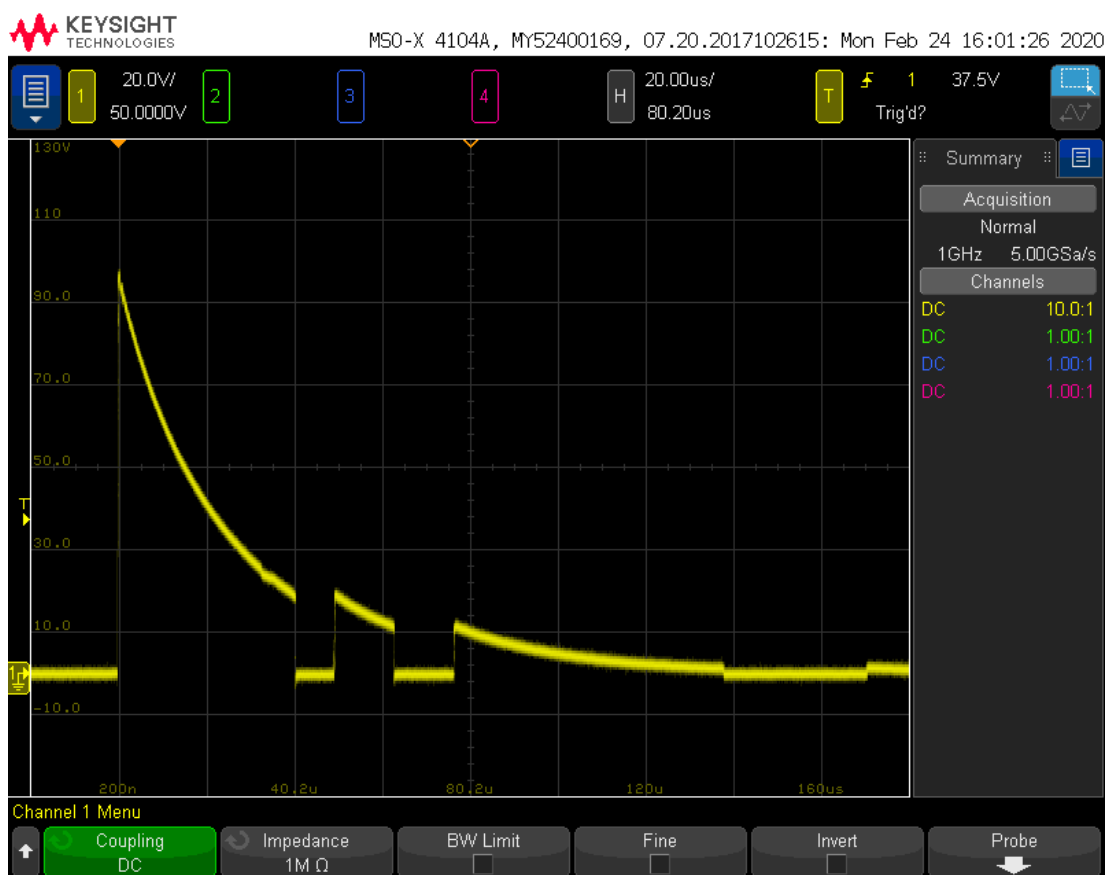
Testi so pokazali točno to, kar smo pričakovali: skakanje kontaktov.



Slika 2.7: Slika releja serije H proizvajalca Meder.



Slika 2.8: Shema vezja za merjenje relejev.



Slika 2.9: Skakanje kontaktov pri releju proizvajalca Medler electronics.

Po specifikacijah bo največji tok čez rele 10 A, saj imamo maksimalno napetost 15 kV in kondenzator praznimo z $1500\ \Omega$ uporom. Zaradi varnosti sem pri merjenju sem spremenil RC konstanto iz $1500\ \Omega$ in $100\ \text{pF}$ na $10\ \Omega$ in $10\ \text{nF}$ katero sem napajal iz 100 V. Na posnetku zaslona iz osciloskopa se lepo vidi razklenitev pri $40\ \mu\text{s}$ in $55\ \mu\text{s}$. Po ponovitvah sem ugotovil, da so razklenitve časovno zelo konstantne. Nastala je ideja o vezanju dveh ali več enakih relejev vzporedno in vzbujanje le teh s časovnim zamikom, saj bi tako premostili razklenitev. Vendar bi s tem dodali kapacitivnost v sistem na katero moramo biti zelo pozorni saj standard dovoljuje maksimalno 20 ns deviacije časovne konstante. Iz radovednosti sem naredil meritve še pri višjih napajalnih napetostih vzbujevalne tuljave, kjer sem predpostavljal, da bo magnetno polje dovolj močno, da se kontakt ne bo

uspel odbiti. Vendar temu ni bilo tako saj tudi pri trojni napajalni napetosti so se prekitivne še vedno dogajale.

2.2.4.2 Komercialna tranzistorska rešitev

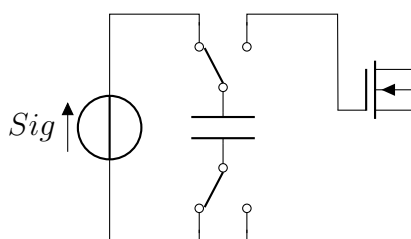
Mojo pozornost je pritegnil tudi izdelek podjetja Behlke, katero se ukvarja z visokonapetostno in močnostno elektroniko. Izdelek je bil HTS 181-02-C [12] hitro visokonapetostno tranzistorsko stikalo. Dotični model ima maskimalno napetost 18 kV ter maksimalno tokovno špico 12 A. Malo manj vzpodbudne so številke za čas naraščanja saj v naših primerih bi bile od 12 ns do 25 ns. Kar je precej več kot 10 ns kot jih zahteva standard. Cena takega stikala je okoli 1100€, tako da zopet presega naš proračun. Vendar sem našel sliko odprtega stikala, kar mi je porodilo idejo o samoizdelavi tranzistorskega visokonapetostnega stikala.

2.2.4.3 Samogradnja tranzistorskega visokonapetostnega stikala

Pozorno opazovanje slik visokonapetostnih stikal proizvajalca Behlke je prineslo ugotovitve, da je stikalo sestavljeno iz dveh delov: krmilni del in visokonapetostni del. Krmilni del ni zanimiv vendar visokonapetostni je zelo saj se vidi kako je zaporedno nanizanih okoli 10 tranzistorjev. Če predpostavimo, da imajo vsi tranzistorji enake karakteristike in se v istem času začnejo odpirati bo napetost naraščala na vseh enako in skupni dvizni čas bo enak dviznemu času tranzistorja. Prva ovira je bila izbirane polprevodnikov, kateri so primerni za nalogo. IGBTji IXYL60N450 [13] proizvajalca LittleFuse so se na papirju izkazali za najboljše, saj imajo maksimalno VCES napetost 4.5 kV vendar imajo tipični odpiralni čas 55 ns kar je še vedno 5.5 krat preveč.

Sem pa našel tranzistorje kateri so bili namenjeni za 10 kV z risetime okoli 10 ns. Tako bi lahko uporabili dva in ju zbondirali na tiskano vezje in s tem zmanjšali parazitne kapacitivnosti in induktivnosti. Vendar zaradi tako hitrega rise timea spadajo te tranzistorji pod Dual use in za nakup le teh potrebno podpisati NDA. Vendar mi je dalo misliti, če se uporabi najbolj idealne komercialne tranzistorje, jih odstrani iz ohišja, zbondira na tiskano vezje. Kakšne čase bi potem dobili. Preden začnem risati tiskano vezje sem hotel v simulatorju zasno-

vati še krmilnik. Uporabljeni bi bili IGBTji zato je potrebno krmilno napetost pripeljati med vrata in emitor. V mojem primeru je potencial emitorja navijšega IGBTja proti masi 11.25 kV. S primernimi visokonapetostnimi stikali bi lahko krmilil na način "Switched Cap".



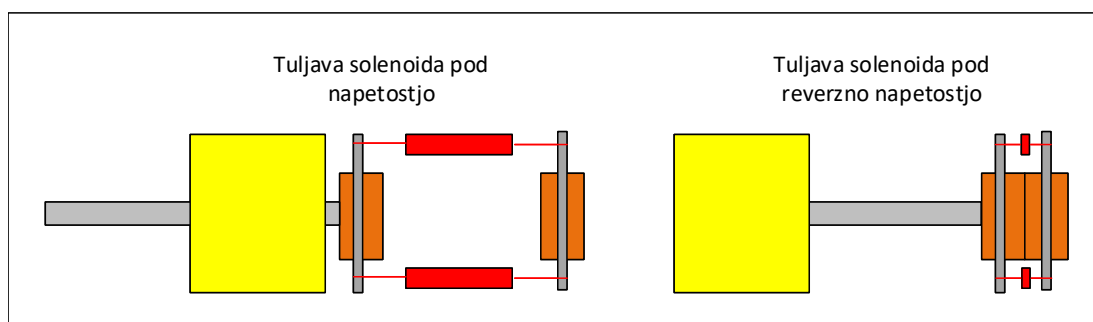
Slika 2.10: Shema idejne zasnove krmiljenja tranzistorja preko "Switched Cap".

Naletel sem pa na članek [14] kjer so potrebovali podobno rešitev, ki so jo reševali z transformatorji kateri so imeli 1:1 razmerje in primerno prebojno trdnost. V simulacijah se je rešitev obnesla. V resničnem svetu bi me pa skrbelo, če bi kakšen krmilnik ali tranzistor le malo zakasnil, saj bi takrat prisala celotna napetost na njemu kar bi seveda pomenilo preobremenitev le tega.

2.2.4.4 Mehanska rešitev

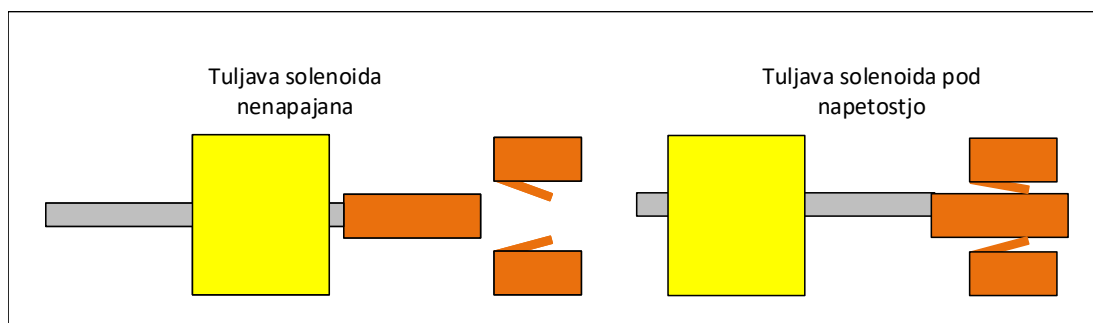
V iskanju nadaljnjih rešitev to pomeni mehanično rešitev in samo eno stikalo ne zaporedne ali vzporedne vezave stikal. Lotili smo se hitrih prototipov štirih stikal:

1. Solenoid, kateri drži razklenjena kontakta, skupaj ju vleče vzmet. Ob prožitvi se obrne polariteta napajanja tuljave solenoida, kateri poleg vzmeti tišči kontakta skupaj.



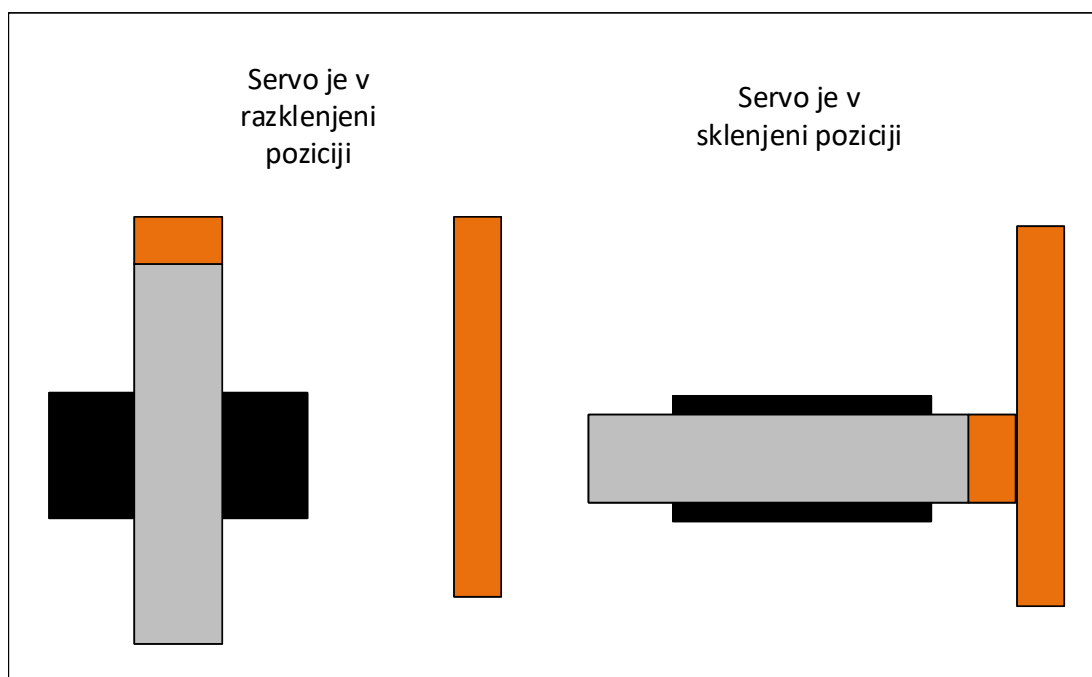
Slika 2.11: Shema stikala s solenoidom verzija 1.

2. Solenoid kateri, porine kontakt in jezička ga ujameta.



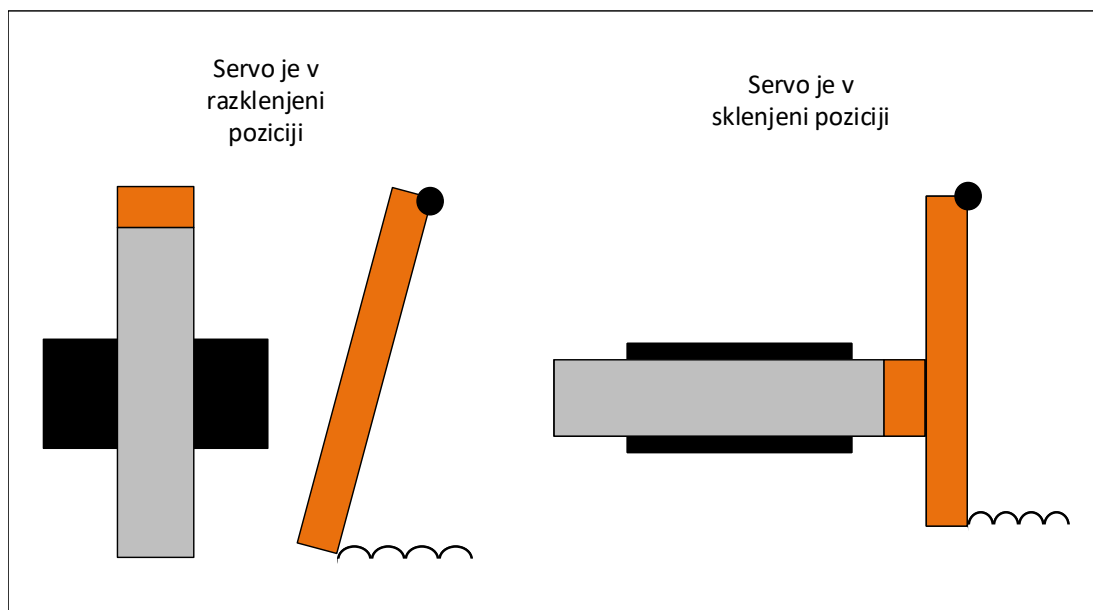
Slika 2.12: Shema stikala s solenoidom verzija 2.

3. Servo motor se zasuče in z drsnim stikalom sklene kontakt.



Slika 2.13: Shema stikala s servo motorjem verzija 1.

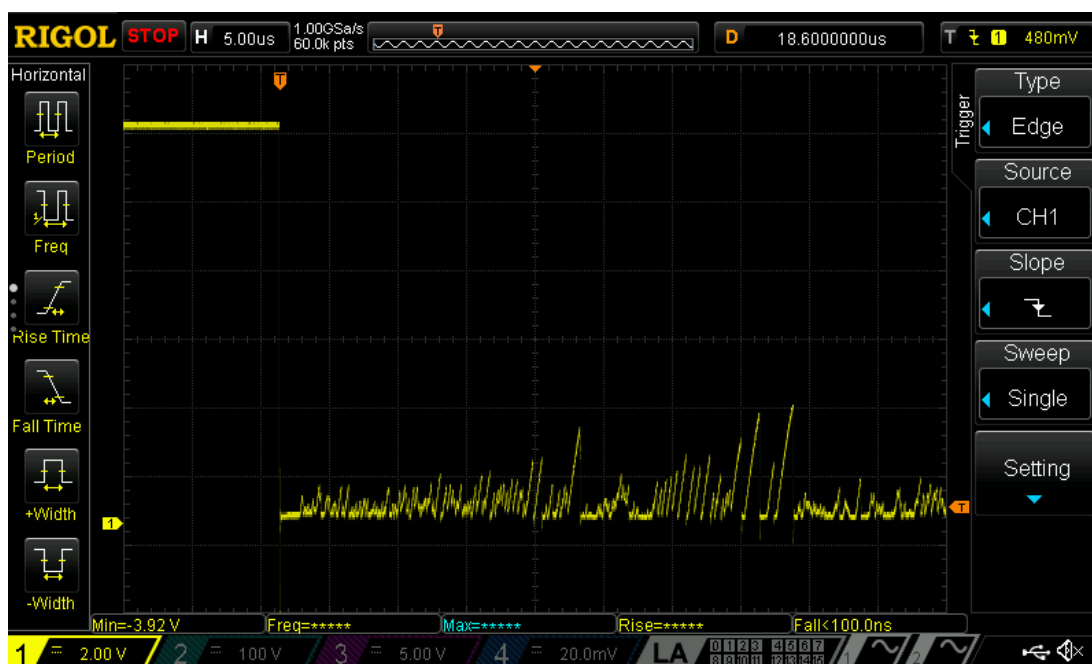
4. Servo motor se zasuče in pritisne na kontakt kateri je na vzmeti.



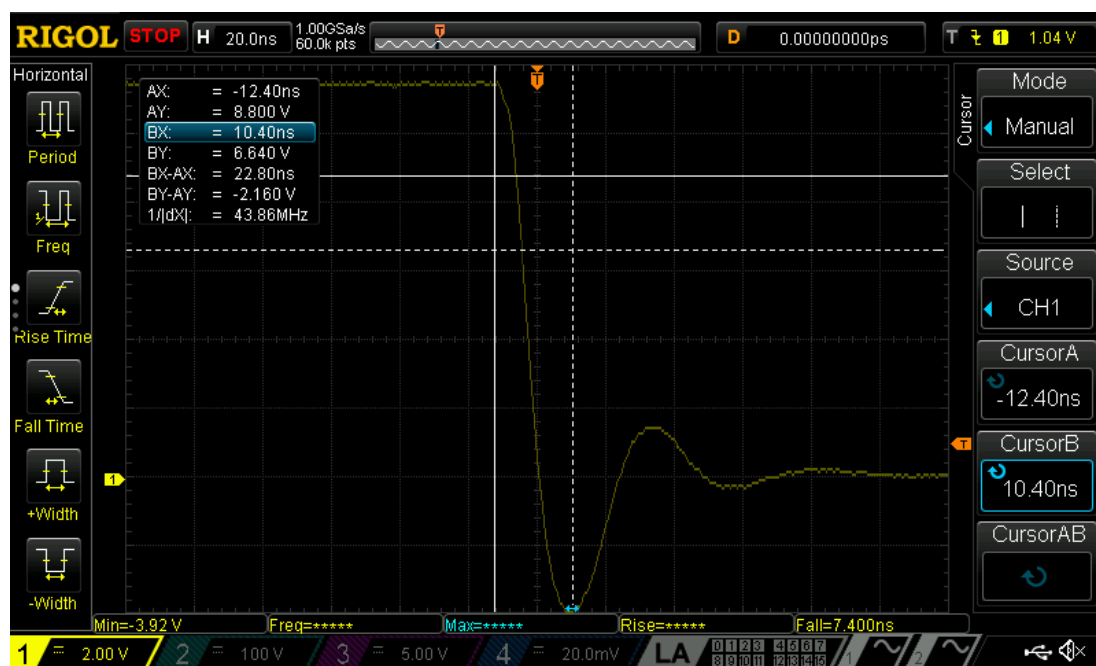
Slika 2.14: Shema stikala s servo motorjem verzija 2.

Za solenoid smo na začetku uporabili manjši model, kateri je bil namenjen konstantnemu delovanju pri 12 V, za hitrejšo delovanje in večjo slilo se ga lahko prenapaja z 40 V za čas 1 s z delovnim ciklom 5%. Izkazal se je za neuporabnega, saj čim se na njega namesti kontakt nima več zastostne moči za premikanje, posebno če bi se moral še upirati sili vzmeti. Za hitri preiskus mojih tez sem naredil solenoid na tuljanviku od transformatorja.

S stikalo s servo motorjem smo imeli dokaj dobre uspehe vendar smo še vedno bili daleč od končne rešitve. Hitre meritve prototipa stikala z servo motorjem verzija 1 so pokazale rise time 10 ns vendar se vseeno pojavljajo manjše prekinitve po sklenitvi kontaktov. Skrbi me pa tudi obraba in oksidacija kontaktov. Rešitev bi bila zaprtje celotnega stikala v vakumsko komoro ali še bolje SF_6 .



Slika 2.15: Potek napetosti po sklenitvi kontaktov pri servo stikalu verzija 1.



Slika 2.16: Potek napetosti po sklenitvi kontaktov pri servo stikalu verzija 1 povecano.

Stikalo s servo motorjem verzija 2 pa je problem počasnega rise tima. Verjetno je kriva vsa parazitna kapacitivnost. Potrebno bi bilo narediti revizijo in skrajšati vse segmente žice in narediti kontakte bolj kompaktne.

3 Sklep

Kljub temu, da se je že ob zasnovi projekta vedelo, da bo celoten projekt izjemo težavno izpeljati v predlaganem časovnem okvirju in proračunu nismo pričakovali takšnih zapletov. Večji del problemov je predstavljala zahtevana visoka napetost, saj se komercialno dobavljive komponente dobijo do okoli 3 kV, za višje napetosti postanejo komponente že težje dobavljive in posledično dražje. Ogromno preglavic je povzročal tudi rele brez skakanja, saj se načeloma uporabljajo za nizke napetosti. Poleg tega vsebujejo nevarne substance kar jih naredi še bolj redke. Kljub temu sem z ugotovitvami prišel do kar nekaj uporabnih rešitev, katere bom še bolj raziskal pri izdelavi diplomske naloge. Do delujočega ESD simulatorja bi lahko prišel z uporabo komercialnega visokonapetostnega nastavljivega napajalnika proizvajalca Applied Kilovolts in visokonapetostnim relejem namenjenim praznjenju kapacitivnih zalogovnikov proizvajalca Gigavac vendar bi taka rešitev podražila projekt za vsaj 5000€, druga možnost je lastni razvoj visokonapetostnega nastavljivega napajalnika in visokonapetostnega releja, katera bi približno enako podražila projekt, vendar bi bilo potrebnih 400 delovnih ur več. V podjetju pa tudi nimamo izkušenj s tako visokimi napetostmi, saj se ukvarjamo z mikroelektroniko.

Literatura

- [1] Microcircuits test standards. Standard, 06 2013.
- [2] For electrostatic discharge sensitivity testing human body model (hbm) - component level. Standard, May 2017.
- [3] Gary Hanington. Using parallel high voltage multipliers for 100kv downhole neutron generator power supplies. *Additional Conferences (Device Packaging, HiTEC, HiTEN, & CICMT)*, 2014:000006–000012, 01 2014.
- [4] *Constant-Voltage Constant-Current Flyback Controller Using Optocoupled Feedback*, 03 2018. Rev. C.
- [5] *For Linear Technology LT3751 Capacitor Charger Controller*, 01 2017. Rev. A.
- [6] *2.2-MHz wide VIN, 1.5-A MOSFET driver, non-synchronous boost controller*, 01 2021. Rev. C.
- [7] *100V Isolated Flyback Controller*, 02 2015. Rev. B.
- [8] *Boost, Flyback, SEPIC and Inverting Controller*, 01 2021. Rev. G.
- [9] *100VIN Micropower No-Opto Isolated Flyback Converter with 150V/2A Switch*, 02 2017. Rev. A.
- [10] *35kV SPST-NO HV Relay*, 06 2017. Rev. 2.
- [11] *H Series Reed Relays*, 01 2015. Rev. 01.
- [12] *Fast High Voltage Transistor Switches*, 03 2013. Rev. 1.
- [13] *High Voltage XPT IGBT*, 11 2013. Rev. 1.

- [14] R. E. Continetti, D. R. Cyr, and D. M. Neumark. Fast 8 kv metal–oxide semiconductor field-effect transistor switch. *Review of Scientific Instruments*, 63(2):1840–1841, 1992.